CLIPPEDIMAGE= JP407297258A

PAT-NO: JP407297258A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07297258 A

TITLE: CARRYING EQUIPMENT OF PLATE BODY

PUBN-DATE: November 10, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ι

AKUMOTO, MASAMI OGAWA, SHIZUO NAGANO, TOSHIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME TOKYO ELECTRON LTD TOKYO ELECTRON KYUSHU KK COUNTRY N/A N/A

APPL-NO: JP06110421

APPL-DATE: April 26, 1994

INT-CL (IPC): H01L021/68; B65G049/07; H01L021/02

ABSTRACT:

PURPOSE: To execute high-speed delivery of a plated body between

first and

second processing apparatuses of the plate body.

CONSTITUTION: Facing an opening SIA for carrying-in and

carrying-out X a

coating/developing apparatus S1 of a semiconductor wafer, an intermediate

delivery stage 41A having also a cooling function and an intermediate delivery

stage 41B used exclusively for delivering the semiconductor wafer onto the

coating/developing apparatus S1 side are provided, while a carrying mechanism

42 equipped with a pincette 44 being movable back and forth is constructed so

that it can be moved up and down and rotated. Besides, a setting stage 53 for

carrying-in and a setting stage 54 for carrying-out are so provided that their

positions are fixed, and a cassette C1 for buffering is disposed at an end of a carrying passage.

COPYRIGHT: (C) 1995, JPO

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-297258

(43)公開日 平成7年(1995)11月10日

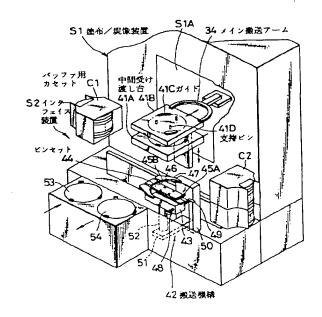
| (51) Int.Cl.* | 識別記号 庁 | ·整理番号 FI | 技術表示箇所 |
|---------------|----------------|-----------|---|
| HO1L 21/38 | A | | |
| B65G 49/07 | С | | |
| H 0 1 L 21/02 | Z | | |
| | | 審査請求 | 未請求 請求項の数4 FD (全 9 頁) |
| (21)出願番号 | 特願平6-110421 | (71)出願人 | 000219967 東京エレクトロン株式会社 |
| | | , | 東京都港区赤坂5丁目3番6号 |
| (22) 出顧日 | 平成6年(1994)4月26 | 1 (71)出顯人 | |
| | | (п)шах | 東京エレクトロン九州株式会社 |
| | | | 佐賀県鳥栖市西新町1375番地41 |
| | | (72)発明者 | 飽本 正巳 |
| | | | 館本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京 エレクトロン九州株式会社館本事業所内 |
| | | (72)発明者 | |
| | | | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京 |
| | | | エレクトロン九州株式会社熊本事業所内 |
| | | | 最終頁に続く |

(54)【発明の名称】 板状体の搬送装置

(57)【要約】

【目的】板状なの第1の処理装置と第2の処理装置との 間で、高速な板状体の受け渡しを行うこと。

【構成】半導体ウェハの塗布/現像装置S1の搬出入口 S1Aに面して、冷却機能を兼ねた中間受け渡し台41 Aと、上記塗布/現像装置S1側へ半導体を渡すための 専用の中間受け渡し台41Bを設ける一方、進退自在な ピンセット44を備えた搬送機構42を昇降自在、回転 自在に構成する。また、搬入載置台53、搬出載置台5 4 を位置固定して設け、搬送路の端にバッファー用カセ ットC1を配置する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 仮状体に所定の処理を行うための第1の 処理装置と第2の処理装置の間で、上記板状体を搬送す る板状体の搬送装置において、

上記第1の処理装置と上記第2の処理装置の間で、上記 板状体を双方向に搬送可能な少なくとも1つの搬送機構 ٤.

上記第1の処理装置に対して上記搬送機構により上記板 状体を受渡しする際に、上記板状体を一時待機させるた めに垂直方向に積層された少なくとも2つの待機部を設 10 けたことを特徴とする板状体の搬送装置。

【請求項2】 複数の待機部のうち、少なくとも1つ は、冷却手段を備えていることを特徴とする請求項1記 載の板状体の拡送装置。

【請求項3】 複数の待機部のうち、少なくとも1つ は、上記板状体を支持可能な支持体を備えていることを 特徴とする請求項1記載の板状体の搬送装置。

【請求項4】 複数の待機部のうち、少なくとも1つ は、上記第10処理装置へ上記板状体を渡すための専用 の待機部であることを特徴とする請求項1記載の板状体 20 の搬送装置。

【発明の詳細は説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、板状体の搬送装置に関

[0002]

【従来の技術】半導体基板(以下ウェハと呼ぶ)の製造 工程においては、多数の処理装置を必要とするため、各 部のレイアウトについては、処理装置や、各処理装置間 のウェハの受け渡しを行うインターフェース装置など を、なるべくコンバクト化して、工場内のスペースをで きるだけ有效に活用することを考慮する必要があるし、 また、スループットの向上を図るために、ウェハの撤送 をできるだけ効率良く行うことが重要である。

【0003】このような点から、例えば従来ウェハにレ ジスト膜の形成及び現像を行う塗布現像処理装置としてい て、図5に示すように構成されるているものがある。図 5の装置でに、処理装置Aの中央に2つに分割されたメ イン搬送路11,12が配置されると共に、夫々にメイ ン搬送アーム13,14が設置されている。とれらメイ 40 ン搬送路11,12の両側には、アドヒージョン部、塗 布部、ベーク部、冷却部、現像部などの処理部15(各 処理部を共通の15の符号で表す)が配置されており、 メイン搬送路11,12間には、メイン搬送アーム1 3. 14間でウェハの受け渡しを行うための待機台16 が介在して設けられている。

【0004~そして、処理部Aに隣接し、露光装置(図 示せず)との間でウェハの搬入搬出を行うためのインタ ーフェース 装置 B には、メイン 搬送路 1 2 の端部に面し て昇降自在で冷却可能な中間受け渡し台21が1個設け 50 おいて、上記第1の処理装置と上記第2の処理装置の間

られると共に、この中間受け渡し台21の両側に2個の バッファー用カセット22が昇降台上に配置されてい る。更に、中間受け渡し台21の前に、図5中、X, Υ, Ζ, θ方向に移動自在な搬送機構23が設けられ、 この搬送機構23に対して中間受け渡し台21と反対側 (外部側, 露光装置側) に、ウェハ搬入載置台24及び 搬出用載置台25が台上に配置されている。

【0005】上記装置では、例えば一方のメイン搬送ア ーム13からウェハを待機台16を介して他方のメイン アーム14に搬送し、更にインターフェース装置Bの中 間受け渡し台21で待機、必要に応じて冷却した後、搬 送機構23により搬出用載置台25に搬送する。また、 露光部から上記処理部A内にウェハを搬入するときは、 逆の径路でウェハを搬送し、双方のウェハの搬入、搬出 のタイミングが大きくずれる場合などには、ウェハはバ ッファー用カセット22内に一時収容し待機させる。 【0006】そして、上記搬送機構23の搬送動作とし て、例えば、中間受け渡し台21に露光前のウェハWが あり、搬入用載置台24に露光後のウェハWがある場 合、搬送機構21で中間受け渡し台21から露光前のウ ェハWを受け取り、バッファー用カセット22内に一旦 収容する。そして、搬送機構21は搬入用載置台24に 移動し、露光後のウェハWを受け取って中間受け渡し台 21にウェハWを渡す。次に、搬送機構21は再びバッ ファー用カセット22に移動し、露光前のウェハWを一 枚受け取り、搬出用載置台25にウェハWを渡す。次 に、搬送機構21は受け渡し台21に移動し、次の搬送 まで待機する。

【0007】また、インターフェース装置の例として、 30 特開平1-318247号公報にて開示されたものがあ

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記装 置の前者においては、搬送機構21が2回バッファー用 カセット22に移動しなければならないため、搬送時間 に無駄がある。また、中間受け渡し台21が空の場合に しか、次のウェハの搬入・搬出ができない。また、後者 においては、給送路1および排送路6が共通化された1 本の搬送路の場合に対する対応が難しく、又、バッファ ー用カセット等を有しておらず、給送路1排送路6側と 搬入路3排出路5側とのタイミングが大きくずれる場合 **に搬送時間の無駄が発生する。**

【0009】本発明は、上記背景にもとになされたもの であり、高いスループットが得られる板状体の搬送装置 を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決する為の手段】請求項1の発明は、板状体 に所定の処理を行うための第1の処理装置と第2の処理 装置の間で、上記板状体を撤送する板状体の搬送装置に 3

で、上記板状体を双方向に搬送可能な少なくとも 1 つの 搬送機構と、上記第1の処理装置に対して上記搬送機構 により上記板状体を受渡しする際に、上記板状体を一時 待機させるために垂直方向に積層された少なくとも2つ の待機部を設けたことを特徴とする。請求項2の発明 は、複数の待機部のうち、少なくとも1つは、冷却手段 を備えていることを特徴とする。請求項3の発明は、複 数の待機部のうち、少なくとも1つは、上記板状体を支 持可能な支持体を備えていることを特徴とする。請求項 4の発明は、甚数の待機部のうち、少なくとも1つは、 上記第1の処型装置へ上記板状体を渡すための専用の待 機部であることを特徴とする。

[0011]

【作用】本発明の板状体の搬送装置は、板状体に所定の 処理を行うための第1の処理装置と第2の処理装置の間 で、上記板状体を搬送する板状体の搬送装置において、 上記第1の処理装置と上記第2の処理装置の間で、上記 板状体を双方向に搬送可能な少なくとも1つの搬送機構 と、上記第1の処理装置に対して上記搬送機構により上 記板状体を受渡しする際に、上記板状体を一時待機させ るために垂直方向に積層された少なくとも2つの待機部 を設けた、第2の処理装置で処理された板状体を待機部 に待機させた後、直ちに第2の処理装置で処理すべき板 状体を待機部から搬出できる。従って、搬送に要する時 間を短縮することが可能となり、高スループット化が図 れる。

[0012]

【実施例】以下本発明を被処理板状体、例えば半導体ウ ェハの塗布/現像処理ラインに適用した実施例について 説明する。LCD基板上へのレジスト膜塗布現像処理ラ インに適用してもよい。図2において、半導体ウェハに レジスト膜形成処理及び現像処理を行うための第1の処 理装置、例えば塗布/現像装置S1に隣接して、第2の 処理装置、削ええば露光装置(図示せず)との間でウェ ハの搬入及び搬出を行うための搬送装置であるインター フェース装置S2が設置されている。

【0013〕一方、上記塗布/現像装置S1の上記イン ターフェース装置S2とは反対側には、上記装置S1と 隣接して、各工程間ウエハを搬送するためにウェハWを 収納するウェハカセット30を複数個収容例えば、4個 40 直列に載置し、搬送アーム31例えば、2ピンの金属製 載置部を有するアームにより処理前のウェハ₩をウェハ カセット30から1枚ずつ取り出して、載置台32の予 め定められた位置に載置することにより、塗布/現像装 置S1側に搬送する。又、塗布/現像装置S1側で処理 が終了した処理済みのウェハWを上記2ピンのアームの 他のピンの搬送アームによりウェハカセット30に収納 したりするためのローダ・アンローダ装置S3が設置さ れている。

るメイン搬送路32に沿って移動自在でかつ昇降、回転 前後動自在に構成された搬送機構である例えば、2ピン 金属製載置部を有するメイン搬送アーム34が設けられ ている。又、とのメイン搬送路33の左右両側には、と の撤送路33に沿って各種の処理部、例えば、アドヒー ジョン部35、冷却部36、多段に構成されたベーク部 37、レジストスピン塗布部38、現像液スピン塗布す る現像部39,40などが配置されている。

【0015】上記インターフェース装置S2には、上記 メイン搬送路32の端部即ち図1に示す塗布/現像装置 S1のウェハ搬出入□S1Aに面して、ウェハWを一時 待機させるための複数の待機部、例えば上下に離間して 2個の中間受け渡し台41A, 41Bが設けられてい る。との2個の中間受け渡し台41A,41Bは、例え ば垂直方向に同軸的に積層、例えば中間受け渡し台4-1 Aが下に、41Bが上になるように設けられている。 【0016】この中間受け渡し台41Aには、処理済み ウエハを予め定められた次工程に影響しない温度にウエ ハを設定するための手段、との実施例では、冷却手段例 えば、ベルチェ素子等の電子式冷却手段あるいは冷却 水、冷却ガス等の冷媒による冷却手段を内蔵し、載置し たウェハWを冷却可能に構成されている。換言すれば、 処理済ウエハの急冷手段および一時待機機能を備えてい る。また、ウェハWを裏面で支持するための支持体、例 えば3本の上下動する支持ピン(図示せず)が備えられ ており、この支持ピンをウエハを受け入れ搬出に際し、 中間受け渡し台41Aの上面から突出させることによ り、ウェハWを持ち上げ、支持するように構成されてい る。なお、上記中間受け渡し台41Aは、インターフェ ース装置S2の本体フレーム等に固定され、あるいは垂 直方向に移動可能に設けられている。

【0017】一方、上記中間受け渡し台41Bは、固定 して設けられており、上面には、ウェハWを載置した時 **に周縁部に当接し落下移動により位置決めするための部** 材ガイド41Cが設けられている。即ち、内方に下り勾 配の傾斜面を有する構造に構成されている。また、ウエ ハの受け入れ、搬出に際し、中間受け渡し台41Bの上 面から突出し、ウェハWを持ち上げるための支持ピン4 1 Dが3本出没可能に設けられている。との中間受け渡 し台41Bは、例えば、塗布/現像装置S1側に設けら れている搬送アーム34により現像部40に搬出するた め露光処理済みのウェハWを一時的に収容するための専 用の待機部として使用される。なお、中間受け渡し台4 1Aと同様に、冷却手段を内蔵させてもよい。上記受け 渡し台41Aを未露光ウエハの載置台として、41Bを **露**光済ウエハの載置台として専用にするととにより、コ ンタミ防止効果を期待できる。

【0018】上記中間受け渡し台41A,41Bの下方 側には、Y方向即ち上記メイン搬送路33と直交する方 【0014】上記塗布/現像装置S1は、X方向に伸び 50 向に稼働可能に設けられた搬送路に沿って移動自在に撤

40

送機構42が設置されており、この搬送機構42は、昇 降自在かつ回転自在に構成された搬送基台43と、との 搬送基台43上で進退(前後動)自在の板状体保持部材 であるピンセット44が備えられている。

5

【0019】とのピンセット44には、ウエハを受入れ た時のウェハの前端部及び後端部にウェハの前後の位置 を規制(位置決い)するためのウェハ載置面から上方に 突起した段部45A、45Bが設けられている。また、 上記搬送基台43には、ピンセット44が後端位置まで 後退したときに、ピンセット44に保持されているウェ ハの、ピンセット44後端側の周縁に当接する当接部4 6を内面側に形成した位置決め部材47がピンセット4 4の移動路を挟んで両側に固定して設けられている。そ して、ピンセット44が後端位置付近まで後退したと き、ウェハの周縁が上記段部45A及び位置決め部材4 7によって位置規制されることによって、ウェハのセン タリング (中心の位置決め) が行えるように構成されて

【0020】更に、上記搬送基台43の前端部には、ウ ェハの周縁の一部の左右両側に位置するように互いに離 20 間して設けられた発光部48及び受光部49よりなるマ ッピングセンサが進退自在に設けられており、とのマッ ピングセンサに、後述するバッファー用カセットCと対 向した後前進して、ウェハの有無を検出可能に構成され

【0021】また、搬送機構42には、例えばボールネ シ機構により、方向に移動される移動体50が設けられ ており、との移動体50には、例えばボールネジ機構に より2方向に昇降可能に構成された昇降台51が取り付 けられている。更に、との昇降台51には、heta方向に駆 30 動可能な回転軸52が設けられており、との回転軸52 の上端部に上記搬送基台43が取り付けられている。従 って、ピンセット44は、 X 、 Y , Z , θ 方向に移動自 在に構成されている。

【0022】更に、搬送機構42を挟んで塗布/現像装 置S1に対向する位置には、ウェハWの周縁を保持する ガイド部を備えた外部受け渡し用載置部として外部か ら、例えば霞光装置(図示せず)において、露光処理済 一枚のウェハ₩を受け取るための搬入載置台53、さら に外部の露光装置へ未露光処理ウエハを渡すための撤出 載置台54が設けられている。との載置台53、54の 髙さは、露光工程の処理のための搬送ラインの高さに合 致されるのが通常である。他方上記受け渡し台41A、 41Bは、上記装置S1の搬送ライン33の高さに合致 され、両ラインの髙さを結合するピンセット44の嶽送 ラインが上記載置台41A、41Bの下方に位置してい る。なお、これら搬入載置台53, 接出載置台54は、 昇降機構により昇降自在に設けてもよい。また、上記撽 送機構42の搬送路の両端位置付近には、との搬送路に 臨むように撤出入口を向けた状態に、複数枚のウェハW 50 がると、ウェハWはガイド41 C により位置決めされ、

を一時収納するためのバッファー用カセットC1. C2 が、1段あるいは複数段、例えば2段、支持部材(図示 せず) により支持配置されている。即ち、上記塗布/現 像装置S1の上記搬送33と、上記露光装置とのウエハ の受け渡しを行うために、上記受け渡し台41A、41 Bと搬送機構42が配置され、これら上記受渡し台41 A、41Bと上記搬送機構42は、上下方向関係に位置 しているのが特徴である。

【0023】なお、上記塗布/現像装置S1、インター

フェース装置S2、ローダ・アンローダ装置S3は、各 部を制御するコントローラ、マイクロコンピュータ、シ ステム全体を制御するコンピュータ等を有する中央制御 装置(図示せず)により、所定の処理プロセスに従って 自動的に制御され、動作するように構成されている。 【0024】次に、上記実施例の動作、作用について説 明する。ローダ・アンローダ装置S3のカセット30内 に収納されている処理前の処理待ちウェハWの予め定め られたウエハWを1枚、搬送アーム31により取り出し て載置台32まで搬送してこの載置台32上に載置す る。との載置台32上の予め定められた位置決め載置さ れたウェハWをメイン搬送アーム34により受け取り、 所定のプロセスに従って順に、レジスト塗布工程例えば アドヒージョン部35、冷却部36、塗布部38、例え ばレジスト液を滴下スピンコーティングし、ベーク部3 7 でレジスト液の溶剤を蒸発させ、順次搬送して夫々処 理を行い、ウェハWにレジスト膜を形成する。

【0025】上記ベーク部37で高温に加熱されたウエ ハWは、冷却部36で急冷させる。レジスト膜が形成さ せたウェハWは、メイン搬送アーム34で次の露光工程 に搬送するためウェハ搬出入口 S l l に向かって搬送 し、インターフェース装置S2内に設けられている中間 受け渡し台41Aの支持ピン上に載置し渡す。そして、 ビンセット44で搬出するまでの間、中間受け渡し台4 1Aに載置し、必要に応じて次の露光処理のための予め 定められた温度、例えば20℃に冷却する。 露光処理工 程が何等かの原因により渋滞している場合には、カセッ トC2に一時待機させることができる。

【0026】次に、搬送機構42が中間受け渡し台41 Aまで移動し、ピンセット44を上昇させ、とのピンセ ット44上に載置されているウェハ♥の裏面から搬送機 構42のピン44により、上記ウエハWをすくい挙げ、 ビンセット44を下降させて露光工程に向けて搬出する ための搬出載置台54上の予め定められた位置に載置す る。とのウェハWは露光装置側の処理タイミングで搬入 され、露光処理が終了したウェハWは、搬入装置台53 上の予め定められた位置に載置される。とのウェハ₩ は、搬送機構42のピン44がすくい挙げ搬送し、中間 受け渡し台41Bの上昇中の支持ピン41D上へ載置す る。ピン44が回避したのち、との支持ピン41Dが下

6

メイン搬送アーム34がウェハWを受け取りに来るまで、中間受け渡し台41Bに待機する。なお、待機中にウェハWを次の露光後のウエハWを現像するための温度に温度調整例えば、冷却してもよい。現像処理工程待ちのウエハが、何等かの理由により渋滞した場合には、カセットC1に一時待機させることが出来る。

7

【0027】次に中間受け渡し台41Bに待機している露光済みのウェハWをメイン搬送アーム34により受け取る。そして、このウェハWを現像部39にて現像液をウエハW上にパブレーし、回転させて現像処理を行う。あるいは40、ベーク部37に順に搬送して夫々の処理を行い、ローダ・アンローダ装置S3のカセット内に収納する。

【0028】にとで、インターフェース装置S2におけるウェハ搬送について詳述する。先ず、インターフェース装置S2及び露光装置(図示せず)内には、処理すべきウェハは無く、ロット最初のウェハWが塗布/現像装置S1のメイン搬送アーム34によりインターフェース装置S2内に搬入される時点から説明する。

【0029】ベーク部37で短時間にレジスト液の溶剤 20 を蒸発させるための温度に加熱処理されたウェハWを、メイン搬送アーム34で保持して、ウェハ搬出入口S1 Aを通って中間受け渡し台41A上に載置する。ここでウェハWを例えば23℃程度の温度になるように冷却した後、待機している搬送機構42のピンセット44を駆動して中間受け渡し台41Aから上記ウェハWを受け取る。ウェハVを受け取るとピンセット44は下降し始め、直ちに観光装置にウェハWを渡すために、バッファー用カセットC1の方へは移動せず、搬出載置台54に移動し、ウェハWを載置して渡す。搬送機構42は、搬30入載置台53上にはウェハが無いので、中間受け渡し台41Aの所へ移動する。一方、搬出載置台54上のウェハWは、露光装置内に搬送され、露光処理が終了後、搬入載置台53上に載置される。

【0030】次に、搬送機構42は、次に処理すべきウェハWが中間受け渡し台41Aにて冷却され、予め定められた温度に降温され、露光処理が可能であれば、搬出可となり、このウェハWをピンセット44で受け取る。そして、搬出載置台54に移動して、次に露光すべきウェハWを載置して渡す。この時、搬入載置台53上に最初のウェハWが露光処理を終え載置されている場合には、搬送機構42でそのウェハWを受け取り、中間受け渡し台41Bの所に移動する。

【0031】そして、直ちにウェハWを中間受け渡し台41Bに渡す。あるいは、メイン搬送アーム34が次に処理すべきウェハWを搬送して来た時に、渡すようにしてもよい。

【0032】上記のようにして、次々にウェハWを撤送 して各処理をくり返し行うのであるが、塗布/現像装置 S1側と篝光装置側との処理サイクルタイムが異なる、

例えば露光装置側が長い場合とか、あるいは露光装置側 でトラブル等が発生し、処理が一時的に停止したり、処 理能力が低下した場合には、塗布/現像装置S1からィ ンターフェース装置S2に搬入されたウェハWが露光装 置に直ちに搬送する事が不可能となる事態が発生する。 【0033】との場合には、中間受け渡し台41Aで冷 却されたウェハ Ψ を一時的にバッファー用カセットC 1 内に収納し待機させる。バッファー用カセットC 1内に 収納されたウェハWは、一般的に、処理履歴の管理等の 見地から、先入れ先出し、即ち先に収納したウェハから 順に取り出して処理を行う。なお、バッファー用カセッ トC 1 に対してウェハWを収納あるいは取り出す場合に は、搬送機構42の発光部48及び受光部49を、バッ ファー用カセットC1内のウェハWの周縁部の一部がそ の間に入る位置まで前進させた後、搬送基台43を、例 えば連続的にバッファー用カセットC1の最上段から最 下段のレベルまで下降させる。これによって、例えばサ ーボモータにエンコーダを設けて置くことにより、各髙 さ位置と光のオン・オフを対応させたデータを制御部 (図示せず) に取り込んで、バッファー用カセットC1 内の各段のウェハの有無を高速に検出することができ る。との場合、ウェハの髙さ位置を検出できるので、検 出した高さに応じてピンセット44を停止させる。な お、このようにすれば髙速なマッピングを実現できる が、間欠的にマッピングセンサを移動させてもよい。 【0034】図3に示すように、露光処理済みのウェハ ₩を搬送機構42のピンセット44が保持しており、中 間受け渡し台41BにウェハWを渡すために動作し始め るのをスタート時点として、ピンセット44から中間受 け渡し台41BにウェハWを渡すのに必要な時間をt, (例えば、3.0秒)、ピンセット44が中間受け渡し 台41Aの受け渡し位置まで下降移動するのに必要な時 間をt、(例えば1.5秒)、中間受け渡し台41Bか ら冷却されたウェハ₩を受け取るのに必要な時間を t, (例えば3.0秒)、ウェハを受け取った後、下降・水 平移動してバッファー用カセットClまで行くのに必要 な時間をt。(例えば5.0秒)、ウェハをバッファー 用カセットCl内に収納するのに必要な時間をt,(例 えば3.0秒)、先出しすべきウェハの位置まで移動す るのに必要な時間を t。 (例えば1.5秒)、ウェハを 取り出して搬送用載置台54まで搬送し移動するのに必 要な時間をt,(例えば5.5秒)、搬出用載置台54 にウェハを渡すのに必要な時間を t。(例えば3.5 秒)、搬出用載置台54から搬入用載置台53に移動す るのに必要な時間をt。(例えば3.5秒)、搬出用載 置台54から搬入用載置台53に移動するのに必要な時 間をt,(例えば1.5秒)、搬入用載置台53から露 光処理済みのウェハWをピンセット44で受け取るのに 必要な時間を t 1, (例えば3.5秒)、搬入用載置台5 50 3から最初の位置である中間受け渡し台41Bまで上昇

10

移動するのに必要な時間を t , , (例えば3.5秒)とす れば、上記1サイクルタイムT、は、T、= t_1+t_2+ …… t ., となり、例えば t = 3 4 . 5 秒となる。

q

【0035】上記搬送は、中間受け渡し台が41A,4 1 Bの2個の場合であるが、従来のように中間受け渡し 台が41Aの1個のみである場合は、次のようになる。 ピンセット44が中間受け渡し台41Aでの受け渡し位 置にあり、冷却されたウェハWを受け取るのに必要な時 間がt,、バッファー用力セットC1まで移動する時間 がt. 、収納する時間がt,、搬入用載置台53上の露 10 光処理済みのウェハWを優先して搬送するために搬入用 載置台53に移動する時間が概ねt。+t,-t,、ウェ ハを受け取る時間がtュ。、ことから最初の位置である中 間受け渡し台41Aまで移動する時間が概ねtュュt.。次に、搬出用載置台54に露光すべきウェハを渡 す必要があるために、バッファー用カセットC1内の先 出しウェハの位置まで移動する時間がも、牛も、ウェハ を取り出して推出用載置台54に移動する時間がt,、 再び最初の中間受け渡し台41Aまで移動する時間が t $_{1}$ + $_{1}$ 1 - $_{1}$ 2 $_{2}$ 2 $_{3}$ 5 $_{4}$ 5 $_{5}$ 7 $_{1}$ 5 $_{5}$ 7 $_{7}$ 7 $_{1}$ 7 $_{1}$ 7 $_{2}$ 8 $_{3}$ 7 $_{4}$ 7 $_{5}$ 8 $_{5}$ 9 $_{7}$ 9 $_{$ $_{3}+t_{4}+t_{5}+(t_{6}+t_{7}-t_{9})+t_{10}+(t_{11}$ t_2) + t_1 + (t_4 + t_6) + t_7 + (t_9 + t_{11} - t_2) =40.5秒となり、本発明の実施例の場合と比較して 6秒程度長くかかる。

【0036】更に、本実施例では、中間受け渡し台を2 個備えいるために、例えば冷却可能な中間受け渡し台4 1が空いておれば、直ちに次のウェハを受け取り冷却可 能であり、又、中間受け渡し台41Bが空いておれば、 直ちに露光処理後のウェハを載置でき、かつメイン搬送 すことが可能である。従って、搬送機構が搬送可能な状 態になるまで待機する等の時間の浪費を極力少なくする ととができる.

【0037】なお、上記実施例では、複数の待機部とし て中間受け渡し台41A,41Bの2個を設けた例につ いて説明したが、夫々を2個以上設けるように構成して もよい。また 複数の待機部を垂直方向に積層して配置 した例について説明したが、水平方向に並設するように 構成してもよい。更に、待機部を3個以上設ける場合、 そのうちすくなくとも1つを塗布/現像装置S1側にウ 40 ェハを渡すための専用とし、他のものを受け・渡し共用 として利用したり、あるいは処理プロセス等の条件に対 応して、受け取り専用・渡し専用にと指定変更して利用 するように構成してもよい。

【0038】次に、塗布/現像装置S1の構成例として は、図2に示す例の他に、図4に示すように構成しても よい。なお、図2と同一部分については、同一番号を付 してある。メイン搬送路を2つのメイン搬送33A,3 3Bに、わずかな間隙をもって分割可能に構成すると共 に、夫々上記メイン撤送アームと同様の構成のメイン撤 50 を、次のロットの加熱温度に設定し直したり、あるいは

送アーム34A.34Bが設置されている。これらメイ ン搬送路33A,33Bの両側には、夫々、例えば塗布 部38及び現像部39,40の並びと、熱処理部等との 並びが設置されている。図中、待機部55は、例えばメ イン搬送アーム34A、34B間のウェハ受け渡しを行 うために、ウェハを一時待機させたり、あるいは、他の ウェハを優先して搬送しなければならないような時に後 回しにできるウェハを一時待機させるための待機場所で ある。

【0039】図4は展開図であるため、実際には各熱処 理部等は上下に積層された構造となっている。例えば、 アドヒージョン部35が最上段、冷却部36が最下段に 配置されている。なお、待機部55は、図4では最上段 に設置されているが、中段あるいは最下段に設置しても よい。また、冷却部36を待機部55の代りに利用する ようにしてもよい。更に、各ベーク部37は、加熱の目 的に対応して、例えば、レジスト塗布後のプリベーキン グ、現像処理後のポストベーキング、あるいは露光処理 後のポストエキスポージャベーキング等に使い分けるよ ろにしてもよい。

【0040】また、上記熱処理部は、多数の同一処理部 から構成されているため、各処理部毎に温度制御等のた めのコントローラを使用すると、コントローラの必要数 が多くなり、コストアップとなる。そこで、例えばコン トローラをマルチチャンネル化して、1台のコントロー ラで4チャンネル、8チャンネルと複数の制御が可能と なるように構成してもよい。

[0041]また、塗布部38、現像部39,40等に 使用するレジスト液や現像液等の処理液の温度調整機構 アーム34で直ちに塗布/現像装置S1側にウェハを渡 30 においては、例えば熱交換部分等の温調ユニットを共用 してもよい。こうすることにより、機構の簡略化が計れ ると同時に、例えば塗布部38,38に同一条件で温調 されたレジスト液を、また現像部39,40に同様に同 一条件で温調された現像液を供給できるようになり、各 処理の均一化が可能となる。

【0042】また、処理部が増え、ウェハ径が大きくな るに連れ、装置全体の寸法も大きくなるため、メイン搬 送路33A,33Bの長さも長くなり、ウェハ搬送時間 も長くなるので、メイン搬送アーム34A,34Bの搬 送速度も速くする必要がある。そとで、例えばメイン搬 送アーム34A,34Bの搬送速度特性として、加速期 間の初めや終わりの付近及び減速期間の初めや終わりの 付近の期間において、急峻直線的な加速ではなく、丸味 を帯びた特性、例えばS字カーブを描くような特性にて 搬送動作させてもよい。こうすることにより、従来のよ うな急加速によるメイン搬送アーム34A.34B等の 振動発生を防止しつつ、高速搬送が可能となる。

【0043】また、例えば、現ロットの最後のウェハが 加熱処理を終え、搬出されたベーク部37の設定温度

現ロット、次のロットの加熱温度に予め設定されたベー ク部37を選択して使用できるように、システムを自動 制御することにより、現ロットの処理に引き続いて異種 フローの次のロットを直ちに投入可能に構成してもよ 63.

【0044】さらに、インターフェース装置S2から、 例えばメイン搬送アーム34Bで受け取った露光処理済 みのウェハを、図4で右側に位置する何れかのベーク部 37内に搬入し、露光処理後のポストエクスポージャベ ーキング処理を行うようにしてもよい。この場合、ベー 10 説明図である。 ク部37内において、ウェハ支持ピン(図示せず)上に ウェハを支持し、熱板(図示せず)から持ち上げ離間し た状態で待機可能に構成しておくことにより、オーバー ベークを防止することができる。例えば、所定の加熱時 間よりも、メイン搬送アーム34Bが次に搬出に来るま での時間の方が長い場合、その差だけ待機させた後に加 熱を開始することにより、オーバーベークを防止し、か つ、加熱処理終了のタイミングと搬出とのタイミングを 合致させることが可能となる。搬出後、ウェハは冷却部 に搬送されて、例えば常温程度になるように冷却され る。従って、加熱終了から冷却までの時間を一定にする ことも可能となり、処理の均一化が計れる。この時間の 管理は、例えば化学増幅型レジスト膜の処理プロセスに おいて重要である。

【0045】はお、本発明は、半導体ウェハの塗布/現*

*像装置に限らず、LCD基板、ガラス基板などに対して 処理を行う装置に適用することができる。

【発明の効果】上記したように、本発明によれば、第 1 の処理装置と第2の処理装置間、板状体を迅速に搬送す ることができるので、処理装置の高スループット化が可 能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例の要部を示す斜視図である。

【図2】本発明の実施例を利用した処理装置を示す平面

【図3】本発明の実施例の搬送動作を示す説明図であ

【図4】本発明の実施例を利用した処理装置の他の処理 装置を示す展開図である。

【図5】従来の搬送装置を利用した処理装置の一例を示 す平面図である。

【符号の説明】

S1 塗布/現像装置

S2 インターフェース装置

20 41A, 41B 中間受け渡し台

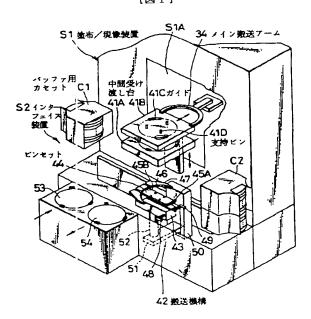
4 2 搬送機構

C1 バッファー用カセット

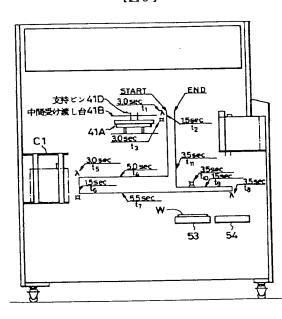
53 搬入載置台

54 搬出載置台

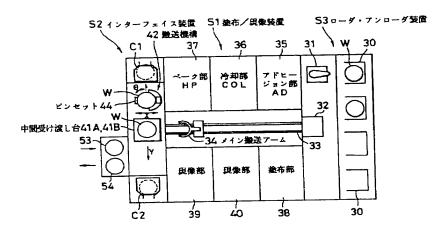
[図1]



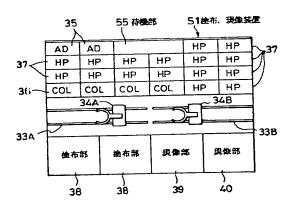
[図3]



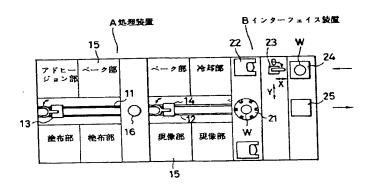
[図2]



[図4]



[図5]



特開平7-297258

フロントページの続き

(72)発明者 永野: 俊彦

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 東京 エレクトロン九州株式会社熊本事業所内